	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XDP210</b>	文件编号	XS-D-010
	<b>PNP 型达林顿晶体管</b>	版本号	16-A1-04
		页码	1/2

## 1 主要用途及主要特点

### 1.1 主要用途

W2XDP210 封装的成品管，主要用于小信号的功率放大和电机驱动的电路上。

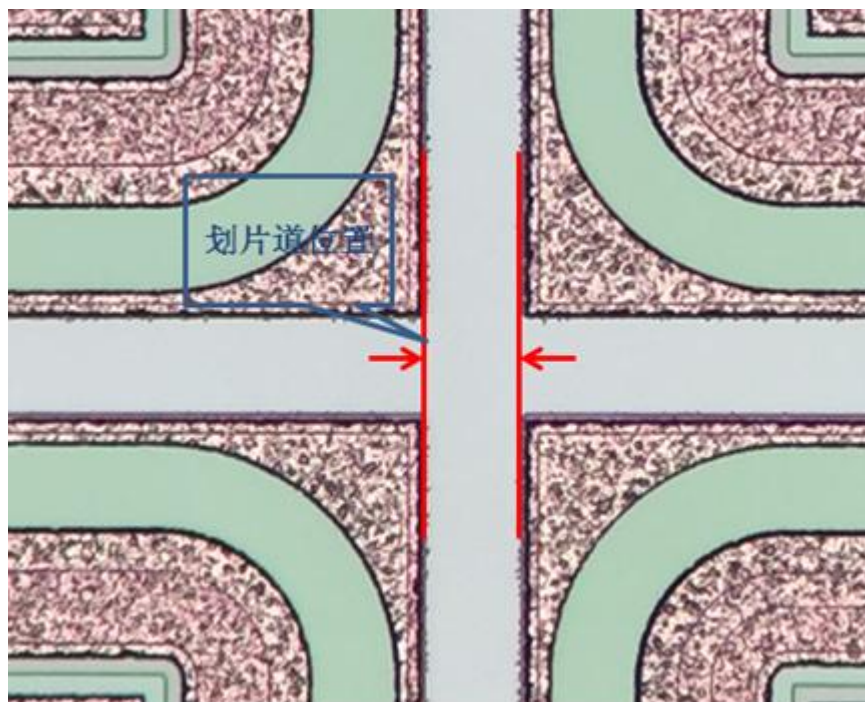
### 1.2 主要特点

- 高温特性好
- 共发射极正向电流传输比  $h_{FE}$  大
- 反向漏电小

## 2 芯片数据

芯片示意图		芯片尺寸 (mm×mm)	2.10×2.10	
		芯片厚度 (μm)	260±20	
		划片道尺寸 (μm)	54	
		键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	基区	444×589
			发射区	448×608
		钝化层		Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
		正面电极	金属	铝
			厚度 (μm)	5.0±1.0
		背面电极	表层金属	银
		硅片直径 (mm)		φ125
		装片要求 (推荐)		铅锡银
键合要求 (推荐)		铝丝; E区: φ150 μm, 一根; B区: φ150 μm, 一根;		

\* 划片道位置示意图:




江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XDP210</b>	文件编号	XS-D-010
	<b>PNP 型达林顿晶体管</b>	版本号	16-A1-04
		页码	2/2

### 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

#### 3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	$V_{CB0}$	-100	V	推荐封装形式: to-220 推荐成品型号: 
集电极-发射极电压	$V_{CE0}$	-100	V	
发射极-基极电压	$V_{EB0}$	-7	V	
集电极电流	$I_C$	-8	A	
耗散功率( $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )	$P_{tot}$	2	W	
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

#### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=-100\text{V}, I_E=0$			-10	$\mu\text{A}$
发射极-基极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=-7\text{V}, I_C=0$			-100	mA
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}$	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-2\text{A}$	2k			
集电极-发射极饱和电压	$V_{CESat}$	$I_C=-3\text{A}, I_B=-12\text{mA}$			-1.8	V

#### 注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

### 江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532